SYNTHESIS, STRUCTURAL, GAS SENSING, IN-SITU XPS AND KPFM INVESTIGATION OF PLD GROWN 2D MATERIALS BASED NANOSTRUCTURES

Prashant Bisht

DEPARTMENT OF PHYSICS

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

JULY 2023

SYNTHESIS, STRUCTURAL, GAS SENSING, IN-SITU XPS AND KPFM INVESTIGATION OF PLD GROWN 2D MATERIALS BASED NANOSTRUCTURES

by

Prashant Bisht

Department of Physics

Submitted

in fulfilment of requirements of degree of Doctor of Philosophy

to the

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

Dedication

This dissertation is dedicated to my parents Mr. Santan Singh and Mrs. Poonam Bisht. Their support, blessings, encouragement, and constant love have sustained me throughout my life.

CERTIFICATE

I am satisfied that the thesis entitled **"Synthesis, structural, gas sensing, In-situ XPS and KPFM investigation of PLD grown 2D materials-based nanostructures"** submitted by Mr. Prashant Bisht is worthy of consideration for the award of the degree of **Doctor of Philosophy** and is a record of original and bonafide research work carried out by him under our supervision. The results contained in it have not been submitted in part or full to any other university or institute for the award of any degree/diploma.

Prof. B. R. Mehta
Department of Physics
Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi-110016, India

Prof J.P Singh
Department of Physics
Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi-110016, India

Date: 26th July 2023

ACKNOWLEDGEMENTS

The journey of this doctoral thesis might have been a fond illusion without the contribution and support from many inspiring individuals that create a productive environment for me to work in. Therefore, I would like to express my sincere gratitude to all the people who contributed to forming such a stimulating atmosphere that helped me over the years to complete my work successfully.

Firstly, I wish to acknowledge my sincere gratitude towards my thesis supervisor ***Prof. B. R. Mehta****, who contributed significantly to shaping and guiding the direction for my thesis work. I am profoundly grateful to him for providing me with an environment where I learned from his knowledge, experience and wisdom that enabled me to complete this study. He has always inspired me with his endless patience, in-depth knowledge, and dedication to accomplish tasks at stipulated time. The allegiance with which he handles such a large group and is always willing to give new ideas and implement them is highly motivational. I would also like to express my thanks to* ***Dr. Poonam Mehta.*** *She has always motivated me and given moral support in the most caring way during my thesis work.*

I am highly obliged to my co-supervisor ***Prof J.P Singh*** *for the valued support and suggestions which helped me in consolidation and realization of this work.*

Besides my supervisors, I sincerely thank and appreciate the efforts of the SRC members, ***Prof. Pankaj Srivastava****,* ***Prof. Rajendra Singh,*** *and* ***Prof. Pravin P Ingole,*** *for their ever-helping approach and supportive nature.*

I am thankful to ***Prof. Ratan Mala Chatterjee, and Prof. Pankaj Srivastava,*** *Head of the Department, Physics, IIT Delhi, for providing necessary facilities.*

I feel fortunate to be associated with Thin Film Lab, which brings along an immense history of research and a tradition of dedication and innovation. I would also like to thank ***Dr. Deepak Varandani, Dr. Khushboo Agarwal, Dr. Dipika Sharma, Dr. Vinod Poonia, Dr. Rishabh Sharma, Dr. Arvind, Dr. Nisha Kodan, Dr. Vishakha Kaushik, Mr Abhishek Ghosh and Ms Narinder Kaur*** *from whom I learned my things. I wish to extend a word of thanks to* ***Mr Saurabh Singh*** *and* ***Mr B.R. Khatri****, who helped me in technical and non-technical aspects of research. I am much obliged to be associated with such a large and helping colleagues at a thin film laboratory.*

I feel privileged to work with ***Dr. Branson Belle, Dr. Ayaz Ali, Dr. Ozhan Kyobasi, Dr. Ingvild, Dr. Martin*** *and* ***Dr. Per Erik Vullum, from SINTEF Norway*** *who performed many experiments along with me and provided valuable suggestions on writing and understanding many aspects of research. I thank them for their meticulous and patient effort in enriching the quality of my research work.*

I wish to extend heartfelt thanks to ***Ms Pallavi Aggarwal and Mr Abhishek Ghosh*** *for being by my side during the peak time of my experimental work. Their friendship and support were a great source of encouragement and have spent the most enlightening time of my research life. I sincerely thank and*

acknowledge the useful comments and insightful discussions that have helped me throughout my doctorate journey.

I am delighted to express my sincere appreciation to ***my family*** *for their love, support and understanding that allowed me to nurture my dream and keep looking forward to more exceptional achievements in the future. I am incredibly grateful to my siblings* ***Sushant Bisht, Aditi Bisht*** *and* ***Kashvi Bisht*** *who encouraged and helped me at every stage of my personal and academic life and longed to see this achievement come true.*

I gratefully acknowledge the University grant commission (UGC) for providing the funding support and Senior Research Fellowship for this study.

Above all, I owe it all to Almighty God for granting me the wisdom, health, and strength to complete this task and enabling me to compile it.

Prashant Bisht

Date*: 26-07-2023* ***Place****: New Delhi*

ABSTRACT

Two dimensional layered materials with atomic scale thickness and layered structure have gained substantial research interest due to their fascinating properties like high specific area, tunable bandgap, strong coulomb interaction, and ease of making heterostructures at atomic thickness. This makes them suitable materials for various application in electronics, photonics and desirable for interdisciplinary research fields like catalysis, sensors, biosensors, neuromorphic computing, renewable energy etc. However, adoption of these materials for practical application requires an extensive understanding of their physical and chemical properties. Also, scalable synthesis of 2D materials with precise control over the growth is a major challenge.

In the present study, pulsed laser deposition (PLD) technique was used to synthesize high quality, large area, few layered thin films of MoO_3, WS_2, and SnS. These materials belong to three distinct families of 2D materials, namely transition metal oxide, transition metal di and mono chalcogenides. Gas sensing properties of these films were studied to understand and achieve highly selective sensor at low operating temperature with limit of detection in parts per billion (ppb).

Synthesis of α-MoO_3 layered thin film of varying thickness of 6, 18 and 70 nm was achieved through PLD. All the growth parameters were optimized, and the three distinct thicknesses were obtained by changing the number of laser pulse. X-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopy confirmed the

formation of anisotropic α-MoO_3. Atomic force microscopy (AFM) images showed the evolution of morphology from 2D layers to oriented crystallite growth with increase in film thickness. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) measurements depicted higher concentration of oxygen vacancies in 70 nm thin film sample and higher oxygen adsorption in 6nm thick 2D layered sample. Thickness dependent gas sensing behaviour was studied towards NO_2 gas. 2D layered sample showed highest response of about 25 % at lower temperature (100 °C). It also exhibited lower detection limits (100 ppb) and selectivity towards NO_2 gas. Comparatively, TF showed poor response (4%) towards NO_2 at 100 ℃ but got increased gradually to 35% at 250 °C indicating higher diffusion of analyte gas due to its higher thickness. A change from n-type to p-type gas sensing response was observed with decreasing thickness of the α-MoO_3 films which might be attributed to the increased surface adsorption and higher Schottky barrier at metal-MoO_3 junction in sample with lower thickness.

Synthesis of vertically and horizontally oriented WS_2 layered films was achieved by varying the PLD parameters. The samples grown with a combination of lower temperature (400 ℃) and higher pressure (70 mTorr) exhibited a vertical flake-like growth, with a flake thickness of ~ 2-5 nm. However, at higher temperatures (600 ℃) and lower pressure (30 mTorr), planar film growth was obtained. XRD, Raman spectra and XPS spectra confirmed 2H semiconducting phase and high film quality. Whereas FESEM, AFM and cross-sectional transmission electron microscopy (TEM) measurements were utilized to elucidate the growth mechanism. Further,

vertically oriented films showed the best response with selectivity towards NO_2 at room temperature (RT) with limit of detection less than 50 ppb. On the contrary, subdued response was obtained in the case of planar films. The results showed a large dependence of the gas sensing mechanism and parameters on layer orientation, and the crucial role of edge sites.

Synthesis of high quality and ultrathin SnS thin film was achieved via PLD followed by the decoration of noble metal nanoparticles (Ag, Au, and Pd) using gas phase synthesis technique. Growth of SnS film was optimized by varying the growth temperature between RT to 500 ℃. Gas sensing measurements were performed on pristine and metal nanoparticle decorated SnS films to tune the response and selectivity.

To further understand the gas sensing mechanism, In-situ gas sensing techniques were employed to further explore the sensing mechanism in detail. Near ambient pressure (NAP) XPS measurements were performed on α-MoO3 thin films to study the effect of film thickness, morphology, and defects towards NO_2 gas sensing by analysing the change in position and intensity of Mo 3d peak. In-situ Kelvin probe force microscopy (KPFM) was performed on pristine, Ag, and Pd nanoparticle decorated SnS film. In-situ KPFM mapped local changes in the work function of film due to analyte gas. The effect of Ag to enhance NO_2 response and Pd to increase selectivity towards H_2 gas has been manifested from the change in surface potential and work function. These results open opportunities to explore PLD as a potential synthesis technique for 2D materials and give a unique perspective to their applications as gas sensors.

सार

परमाणु पैमाने की मोटाई और स्तरित संरचना के साथ २ डायमेंशनल (2D) स्तरित सामग्री ने अपने आकर्षक गुणों जैसे उच्च विशिष्ट क्षेत्र, ट्यून करने योग्य बैंडगैप, मजबूत कूलम्ब इंटरैक्शन और परमाणु मोटाई पर हेटरोस्ट्रक्चर बनाने में आसानी के कारण पर्याप्त अनुसंधान रुचि प्राप्त की है। यह उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त सामग्री बनाता है और अंतःविषय अनुसंधान क्षेत्रों जैसे कटैलिसीस, सेंसर, बायोसेंसर, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए वांछनीय है। हालांकि, व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए इन सामग्रियों को अपनाने के लिए उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की व्यापक समझ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, विकास पर सटीक नियंत्रण के साथ 2D सामग्री का स्केलेबल संश्लेषण एक बड़ी चुनौती है।

वर्तमान अध्ययन में, धातु MoO_3, WS_2, और SnS की उच्च गुणवत्ता, बड़े क्षेत्र, कुछ स्तरित पतली फिल्मों को संश्लेषित करने के लिए पल्सड लेजर डिपोजिष्ण (PLD) तकनीक का उपयोग किया गया था। ये सामग्रियां 2D सामग्रियों के तीन अलग-अलग परिवारों से संबंधित हैं, अर्थात् संक्रमण धातु ऑक्साइड, संक्रमण धातु डाय और मोनो चालकोजिनाइड्स। इन फिल्मों के गैस सेंसिंग गुणों का अध्ययन भागों प्रति बिलियन (ppb) में पता लगाने की सीमा के साथ कम ऑपरेटिंग तापमान पर अत्यधिक चयनात्मक सेंसर को समझने और प्राप्त करने के लिए किया गया था।

PLD के माध्यम से ६, १८ और ७० एनएम की अलग-अलग मोटाई की α-MoO_3 परतदार पतली फिल्म का संश्लेषण प्राप्त किया गया। सभी विकास मापदंडों को अनुकूलित किया गया था, और लेजर पल्स की संख्या को बदलकर तीन अलग-अलग मोटाई प्राप्त की गई थी। एक्स-रे-डिफ्रेक्षण (XRD) और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने अनिसोट्रोपिक α-MoO_3 के गठन की पुष्टि की। अटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी (AFM) छवियों ने फिल्म की मोटाई में वृद्धि के साथ 2D परतों से उन्मुख क्रिस्टलीय विकास के लिए आकारिकी के विकास को दिखाया। एक्स-रे फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी (XPS) मापों में ७० एनएम पतली फिल्म नमूने में ऑक्सीजन रिक्तियों की उच्च सांद्रता और ६ एनएम मोटी २डी स्तरित नमूने में उच्च ऑक्सीजन सोखना दर्शाया गया है। NO_2 गैस के प्रति मोटाई पर निर्भर गैस संवेदन व्यवहार का अध्ययन किया गया। 2D स्तरित नमूने ने कम तापमान (१०० डिग्री सेल्सियस (°C) पर लगभग २५% की उच्चतम प्रतिक्रिया दिखाई। इसने कम पता लगाने की सीमा (१०० ppb) और NO_2 गैस के प्रति चयनात्मकता भी प्रदर्शित की। तुलनात्मक रूप से, TF ने १००°C पर NO_2 की ओर खराब

प्रतिक्रिया (४%) दिखाई, लेकिन २५०°C पर धीरे-धीरे बढ़कर ३५% हो गई, जो इसकी उच्च मोटाई के कारण विश्लेषण गैस के उच्च प्रसार का संकेत देती है। α-MoO_3 फिल्मों की घटती मोटाई के साथ n-टाइप से p-टाइप गैस सेंसिंग रिस्पांस में बदलाव देखा गया, जो कम मोटाई वाले नमूने में धातु-MoO_3 जंक्शन पर बढ़ी हुई सतह सोखना और उच्च शोटकी बाधा के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

PLD मापदंडों को अलग-अलग करके लंबवत और क्षैतिज रूप से उन्मुख WS_2 स्तरित फिल्मों का संश्लेषण प्राप्त किया गया था। कम तापमान (४०० °C) और उच्च दबाव (७० mTorr) के संयोजन के साथ उगाए गए नमूनों ने ~ २-५ एनएम की परत मोटाई के साथ एक लंबवत परत जैसी वृद्धि प्रदर्शित की। हालांकि, उच्च तापमान (६०० °C) और कम दबाव (३० mTorr) पर, प्लानर फिल्म विकास प्राप्त किया गया था। XRD, रमन स्पेक्ट्रा और XPS स्पेक्ट्रा ने 2H अर्धचालक चरण और उच्च फिल्म गुणवत्ता की पुष्टि की। जबकि फील्ड एमेष्ण स्कैनिंग एलेक्ट्रान मिक्रोस्कोपी (FESEM), AFM और क्रॉस-सेक्शनल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (TEM) मापों का उपयोग विकास तंत्र को स्पष्ट करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, लंबवत उन्मुख फिल्मों ने कमरे के तापमान (RT) पर ५० ppb से कम पहचान की सीमा के साथ NO_2 के प्रति चयनात्मकता के साथ सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई। इसके विपरीत, प्लानर फिल्मों के मामले में दबी हुई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। परिणामों ने परत अभिविन्यास पर गैस संवेदन तंत्र और मापदंडों की एक बड़ी निर्भरता और किनारे की साइटों की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाया।

PLD के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और अल्ट्राथिन SnS पतली फिल्म का संश्लेषण प्राप्त किया गया था, जिसके बाद गैस चरण संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके महान धातु नैनोकणों (Ag, Au, और Pd) की सजावट की गई। कमरे के तापमान से ५०० °C के बीच विकास तापमान को बदलकर SnS फिल्म की वृद्धि को अनुकूलित किया गया था। प्रतिक्रिया और चयनात्मकता को ट्यून करने के लिए प्राचीन और धातु नैनोकणों से सजे SnS फिल्मों पर गैस सेंसिंग मापन किए गए थे।

गैस सेंसिंग मैकेनिज्म को और समझने के लिए, इन-सीटू गैस सेंसिंग तकनीकों को विस्तार से सेंसिंग मैकेनिज्म का पता लगाने के लिए नियोजित किया गया था। Mo-3d पीक की स्थिति और तीव्रता में परिवर्तन का विश्लेषण करके फिल्म की मोटाई, आकारिकी और NO_2 गैस संवेदन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए α-MoO_3 पतली फिल्मों पर नियर अम्बिएंट प्रैशर(NAP) XPS मापन किए गए थे। इन-सीटू केल्विन फोर्स माइक्रोस्कोपी (KPFM) प्राचीन, Ag और Pd नैनोपार्टिकल से सजाए गए SnS फिल्म पर किया गया

था। इन-सीटू KPFM ने विश्लेषण गैस के कारण फिल्म के कार्य समारोह में स्थानीय परिवर्तनों की मैपिंग की। NO_2 प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए Ag का प्रभाव और H_2 गैस के प्रति चयनात्मकता बढ़ाने के लिए Pd का प्रभाव सतह की क्षमता और कार्य समारोह में परिवर्तन से प्रकट हुआ है। ये परिणाम २डी सामग्री के लिए संभावित संश्लेषण तकनीक के रूप में पीएलडी का पता लगाने के अवसर खोलते हैं और गैस सेंसर के रूप में उनके अनुप्रयोगों के लिए एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य देते हैं

TABLE OF CONTENTS

LIST OF FIGURES

LIST OF TABLES

ABBREVIATIONS

DOS	Density of states
vdW	van der Waals
MBE	Molecular beam epitaxy
XRR	X-ray reflectivity
XRD	X-ray diffraction
FESEM	Field electron scanning electron microscopy
XPS	X-ray photoelectron spectroscopy
B.E.	Binding energy
MFC	Mass flow controller
2D	Two dimensional
3D	Three dimensional
EDX	Electron diffraction analysis
TEM	Transmission electron microscopy
HRTEM	High-resolution transmission electron microscopy
AFM	Atomic force microscopy
TMD	Transition metal dichalcogenides
SC	Surface charge
SPM	Scanning probe microscope
PSPD	Position-sensitive photodetector
PECVD	plasma-enhanced chemical vapor deposition
JCPDS	Joint Committee on Powder Diffraction Standards
BSE	Backscattered electron
PLD	Pulsed laser deposition
IGPS	Integrated gas phase synthesis setup
PVD	Physical vapour deposition
PVA	Polyvinyl alcohol
KrF	Krypton flouride
EDS	Energy dispersive spectrometer
CB	Conduction band

VB	Valance band
SP	Surface potential
KPFM	Kelvin probe force microscopy
CCD	Charge coupled device
LOD	Limit of detection